

ЭТИКЕТКА

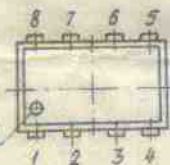
Микросхемы типа КР159НТ1А, КР159НТ1Б,
 КР159НТ1В, КР159НТ1Г, КР159НТ1Д, КР159НТ1Е
 соответствуют ГОСТ 18725-73 и техническим
 условиям 3.456.006 ТУ

БАЗОВАЯ СХЕМА ДИМЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Схема расположения выводов
 (нумерация выводов дана условно)

Таблица назначения
 выводов

| Вывод | Назначение |
|-------|---------------|
| 2 | Коллектор VT1 |
| 3 | База VT1 |
| 4 | Эмиттер VT1 |
| 5 | Эмиттер VT2 |
| 6 | База VT2 |
| 7 | Коллектор VT2 |



Ключ

Масса не более 1,0 г.

Содержание драгоценных металлов
 в 1000 шт микросхем
 золото

0,2100МГ-Зл999,9

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

| Наименование параметра, режим измерения, единица измерения | Буквенное обозначение | Типовым | Норма | |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | | не менее | не более |
| Обратный ток коллектора, нА $I_{КБ} = 20 \text{ В}$ | $I_{КБ}$ | KP159HT1A- KP159HT1E | - | 200 |
| Обратный ток эмиттера, нА $U_{ЗБ} = 4 \text{ В}$ | $I_{ЭБ}$ | KP159HT1A- KP159HT1E | - | 500 |
| Ток утечки между транзисторами, нА $U_{Т1Т2} = 20 \text{ В}$ | $I_{Т1Т2}$ | KP159HT1A- KP159HT1E | - | 20 |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 5 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$ | $h_{21Э}^{ст}$ | KP159HT1A, KP159HT1Г | 20 | 80 |
| | | KP159HT1Б, KP159HT1Д | 60 | 160 |
| | | KP159HT1В, KP159HT1Е | 80 | - |
| | | KP159HT1А, KP159HT1Б | 0,35* | - |
| Отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 2 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$ | $h_{21Э}^{ст}$ $h_{21Э}^{ст}$ | KP159HT1Г, KP159HT1Д | 0,75 | - |
| | | KP159HT1В, KP159HT1Е | 0,35 | - |
| | | KP159HT1В, KP159HT1Е | 0,75 | - |
| | | KP159HT1А, KP159HT1Б | 2,0 | - |

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте
 $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 3,0 \text{ мА}, f = 10^6 \text{ Гц}$

| Наименование параметра, режим измерения, единица измерения | Буквенное обозначение | Типовым | Норма | |
|---|-----------------------|---|----------|----------|
| | | | не менее | не более |
| Модуль разности прямых амплитуд на переходах эмиттер-база, мВ $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 1,0 \text{ мА}$ | $U_{ЗБ1} - U_{ЗБ2}$ | KP159HT1A, KP159HT1Б, KP159HT1Г, KP159HT1Д, KP159HT1Е | - | 3 |
| | | | - | 15 |

Примечания: * За $h_{21Э1}$ принимается значение параметра транзистора с меньшим коэффициентом передачи тока.

** Норма $h_{21Э}$ задана для транзистора микроскопии с большим значением этого параметра.

*** Для изделий с ГЭК $h_{21Э} / h_{21Э1} \geq 2,5$

ОТК

